

مطالعه نظری ساختار و ویژگیهای الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای بهبود کارایی سلولهای خورشیدی

پروین صالحی ابر^{او*}، سید مجید هاشمیان زاده^۲ و سید وحید موسوی^۱

۱- کارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 ۲- دانشیار شیمی فیزیک، آزمایشگاه شبیهسازی و تحقیقاتی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

دریافت: مرداد ۱۳۹۲، بازنگری: مهر ۱۳۹۲، پذیرش: آبان ۱۳۹۲

چکیده: باتوجه به ماهیت فرایند فوتو ولتائیک در سلولهای خورشیدی، مواد جاذب نور تنها سطح انرژی خاصی از فوتون را جذب میکنند. بنابراین، تنظیم شکاف انرژی نیم رساناها در سلولهای خورشیدی حائز اهمیت است. در این مقاله ساختار و ویژگیهای الکترونیکی نقطهی کوانتومی تیتانیم دی اکسید به عنوان تابعی از اندازه برای بهبود بازده سلولهای خورشیدی با استفاده از روش آغازی بررسی شده است و از سوی دیگر ویژگیهای ساختاری از جمله انرژی کل و ویژگیهای الکترونیکی از جمله چگالی حالتها و چگالی لومو و هومو مورد بررسی قرار گرفته است.

واژدهای کلیدی: سلول های خورشیدی، نقطه ی کوانتومی، بازترکیب، شکاف انرژی، چگالی حالتها

مقدمه

سلولهای خورشیدی ابزاری برای تبدیل فوتون ها به الکتریسیته هستند این سلول ها نیازمند دو تابع، حامل های بار تولید کننده ی نور (الکترون و حفره) در یک ماده جاذب نور و جدایی حامل های بار و رسیدن آن به سطح رسانا برای انتقال الکتریسیته هستند که به این تبدیل ها اثر فتوولتائیک گفته می شود. سلول های خورشیدی برپایه تیتانیم دی اکسید نسل جدید سلول های فتوولتائیک هستند که با توجه به کم هزینه بودن و قابل دسترس بودن واکنشگرها و تجهیزات لازم برای ساخت، این نوع سلول ها می توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای سلول های خورشیدی پایه سیلیکونی مطرح شوند [1].

به هرحال با وجود مزایای زیاد به کارگیری $_{2} \operatorname{TiO}$ در سلول های خورشیدی، اعم از ارزان قیمت بودن، غیرسمی بودن، قابلیت جذب بالا و پایداری نوری و شیمیایی در شرایط واکنش، عواملی وجود دارد که به کارگیری $_{2} \operatorname{TiO}$ را محدود می کنند که ناپایداری و شکاف انرژی غیر مستقیم فاز آناتاز $_{2} \operatorname{TiO}$ و سرعت بالای باز ترکیب الکترون و حفرههای تولید شده در این نیم رسانا، سبب کاهش بازده واکنش فوتوولتائیک میشود. با توجه به ماهیت فرایند فتوولتائیک مواد جاذب نور تنها سطح انرژی خاصی از فوتون را جذب می کنند بدین معنا که اگر فوتون، انرژیی بیشتر از شکاف انرژی داشته باشد انرژی اضافی به جای تولید الکترون– حفره، تولید گرما می کند که این پدیده بازده کلی فرایند فوتوولتائیک در

^{1.} Anatase

salehia_p@yahoo.com *عهدهدار مكاتبات:

نیم رساناها را کاهش میدهد. روشهای متفاوتی برای افزایش بازده بررسی شده است که یکی از این روشها برای غلبه بر این محدودیت، تولید اکسایتونهای چندگانه (MGE') یا حاملهای چند گانه (۲CM') هست [۲ و ۳].

کمترین میزان کارایی اکسایتونها در توده نیم رساناها و تولید اکسایتونهای چند گانه با بازدهی بالا در نانو بلورهای بسیار ریز نیم رساناهاست که این امر منجر به تولید سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی شد (QDs). با کوچک شدن اندازه نانو ذرات نیم رسانا اثرات کوانتومی ظاهر میشود. در نقاط کوانتومی نیز الکترونها بازهای از انرژیها را دارند، اما به دلیل اندازه بسیار کوچک این نانوذرات، ترازهای انرژی در آنها پیوسته نیست وتشکیل این سطوح انرژی گسستهی کوانتیزه مقیاس زمانی بازترکیب را کاهش میدهد [۴]. کاستن یا افزودن تعدادی اتم به نقاط کوانتومی، باعث تغییر در شکاف انرژی میشود که باز هم به در نقاط کوانتومی همیشه بزرگ تر از حالت تودهی ماده است. این خاصیت باعث ایجاد قابلیت تنظیم طول موج تابشی میشود، البته به اندازه ذرات بستگی دارد [۵].

شیوههای محاسباتی

در این پژوهش برای طراحی سامانه مورد نظر و انجام محاسبات مکانیک کوانتومی از نرم افزار کوانتوم اسپرسو^۳ ۲–۳–۴ [۶] استفاده شده است که یک مجموعه یک پارچه از کدهای کامپیوتری برای محاسبات ساختار الکترونیکی ومدل سازی مواد در مقیاس نانو بر اساس نظریه تابع چگالی، تابع موج تخت و شبه پتانسیل های از نوع سخت و نرم است. بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو شامل کدهای محاسباتی اصلی زیر است:

PWscf^{*}: محاسبات خودسازگار با استفاده از PW و DFT CPmd^{*}: محاسبات دینامیک مولکولی برای سامانههای

متناوب با استفاده از PW و DFT

Phonon: محاسبات ارتعاشهای شبکه با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی²

XSPECTRA: محاسبه لبه جذب K طیفهای پرتو ایکس PostProc: ابزارهایی برای پس پردازش دادهها TD-DFPT: محاسبات طیف با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی وابسته به زمان

که در این پژوهش از کد pwscf آن استفاده شده است. که محاسبات خود سازگار را بر اساس تابع موج تخت و نظریه تابع چگالی انجام می دهد.

کدهای کمکی این نرم افزار شامل موارد زیر است:

Pwgui: رابط گرافیکی برای تولید دادمهای ورودی برای pwscf

Xcrysden: برای دیدن ساختار بلوری و باز کردن دادههای خروجی و ورودی

gunplot/xmgrace: برای رسم دادهای ریاضی در ۲ یا ۳ بعد PlotPhon: ابزار رسم طیف پراکندگی فونون

atomic: یک برنامه برای محاسبات اتمی و تولید شبه پتانسیل QHA: ابزاری برای محاسبه چگالی حالت تصویر شده و انرژی

آزاد در تقریب شبه هارمونیک (در رابطه با فونون^۷ مورد استفاده قرار گیرد). که در این مقاله از ۳ کد اول استفاده شده است.

برای رسم ساختارهای اولیه از نرم افزار گوس^۸ ویو استفاده شده است، بدین صورت که ابتدا فایل CIF^۲ [۷] روتایل را برای ساخت توده در ابعاد ۷×۷×۷ گسترش داده، سپس برای مدل نقاط کوانتومی یک قسمت بهتقریب کروی بریده میشود. برای حفظ استوکیومتری خوشههای مشتق شده، بعضی از اتمهای TI یا O خارجی حذف شده و سپس اتمهای O، TI غیر اشباع با اتمهای H بیاثر^{۱۰} میشود. که در نهایت نتیجههایی از بی اثر کردن پیوندهای غیر اشباع به دست میآید. سپس برای صرف نظر کردن از فعل و انفعالات غیر فیزیکی یک لایه خلاء در یک شبکه

^{1.} Multiple excition generation

^{2.} Carrier multiplication

^{3.} Quantum espresso (Open Source Package for Research in Electronic Structure, Simulation, and Optimization)

^{4.} Plane- Wave Self-Consistent Field5. Car-prarinello Molecular Dynamics6. Density-Functional Perturbation Theory (DFPT)7. Phonon8. Gauss View9. Crystallographic Information File10. Terminate

صالحی و همکاران

تتراگونالی به آن افزوده می شود [۲].

مطالعات نظریه تابع دانسیته^۱ با استفاده از کد PWscf در برنامه کوانتوم اسپرسو به اجرا درآمده است. برای این محاسبات از شبه پتانسیل فوق نرم^۲ پیشنهاد شده بهوسیله واندربیلت^۳ استفاده شده و با PBE^۴ تابع ضریب همبستگی تبادل^۵ برای ۱۸ الکترون که شامل حالت والانس پوستههای ۲۶ و ۲۶ برای تیتانیم ۱۸ الکترون که شامل حالت والانس پوستههای ۲۶ و ۲۶ برای تیتانیم ۱۲ الکترون) و پوستههای ۳۶ *۳۵ م۳ ما* ۶۷ برای تیتانیم ۱۲ الکترون) است، تولید شده است. انرژی قطع ۳۵ برای انتخاب شده ۱۳ ایت، درحالی که انرژی قطع برای بسط تابع چگالی بار، حداکثر تا است، درحالی که انرژی قطع برای بسط تابع چگالی بار، حداکثر تا ۱۳ برای توده و با ۴۰۰ Ry مانی ۳۰ برای ساختارهای کوانتومی به برای توده و با NSCF مگرایی، نمونه برداری شده است. بعد از انجام محاسبات محراک، SCF و DOS نتیجههای خروجی با نرم افزار ایکس– ام– گراس² رسم می شود.

نتيجهها و بحثها

توده روتایل تیتانیم دی اکسید

فاز روتایل تیتانیم دی اکسید دارای شبکه چهاروجهی با عاملهای ساختاری $a = b = f_0$ ۹۳ Å و $c = 7_0$ ۹۸ که شامل ۲ اتم تیتانیم و ۴ اتم اکسیژن در هر سلول واحد است که در شکل نشان داده شده است.



در ساختار روتایل تیتانیم دی اکسید، هر اتم تیتانیم با ۶ اتم اکسیژن و هر اتم اکسیژن با ۳ اتم تیتانیم کئوردینه شده است. روتایل _cTiO دارای یک شکاف انرژی مستقیم در حدود ۲٫۱ eV است، که به علت خطاهای GGA کمتر از میزان تجربی آن (evm) است. چگالی حالتهای بهدست آمده از محاسبات در شکل ۲ نشان داده شده است. بررسی جزئی چگالی حالت توده روتایل TiO₂ نشان میدهد که: ۱) بخش پایین تر نوار ظرفیت از پیوندهایی تشکیل شده است که ناشی از کوپلاژ بین اوربیتالهای O-2p و Di-3d است. ۲) بالای نوار ظرفیت به طور عمده از اوربیتال های غیر پیوندی $O-2p \pi$ تشکیل شده است. ۳) نوار رسانایی به طور عمده شامل اوربیتالهای Ti-3d است. ۴) ته نوار رسانایی به طور عمده از اوربیتالهای Ti-3d t₂g تشکیل شده است که به میزان کمی با یکدیگر کوپل شده اند. به طور کلی می توان گفت نوار ظرفیت به طور عمده ناشی از اوربیتال های ۲۶ اتمهای اکسیژن و نوار رسانایی ناشی از اوربتالهای ۳۵ اتمهای تيتانيم است.



شکل ۲ چگالی حالت کلی برای توده روتایل TiO₂ (رنگ سبز) چگالی حالتهای ناشی از اوربیتالهای ۲۶ اتمهای اکسیژن (رنگ آبی) چگالی حالتهای ناشی از اوربیتالهای ۲۵ اتمهای تیتانیم (رنگ قرمز)

نقطهی کوانتومی عریان ۲۲^۷ اتمی ₂ TiO این نقطهی کوانتومی ۲۲ اتمی شامل ۸ اتم تیتانیم و ۱۴ اتم اکسیژن است (شکل ۳) که دارای اندازه مؤثر^۸ Å ۷٫۶۵ است. که این اندازه از رابطه زیر بهدست آمده است:

$$d = [3a^2c(2n_{\rm Ti} + n_0)/4\pi]^{1/2}$$

- 2. Ultrasoft pseudopotentials3. Vanderbilt4. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof6. Xmgrace7. Bare8. Effective size
- Density functional theory (DFT)
 Exchange correlation functional

سال هفتم، شماره ۳، پاییز ۹۲

مطالعه نظری ساختار و ویژگیهای الکترونیکی روتیل ...

که در آن $n_{Ti} e_0 n_{Ti}$ به ترتیب تعداد اتمهای تیتانیم وتعداد اتمهای اکسیژن در نقطهی کوانتومی است [۸]. شکاف انرژی و انرژی کل بهدست آمده به ترتیب برابر eV 7,74 e است. تراز LUMO¹ به طور عمده ناشی از اوربیتالهای 7 اکسیژن تراز HOMO^۲ به طور عمده ناشی از اوربیتالهای 7 اکسیژن است. چگالی حالتهای بهدست آمده از محاسبات در شکل ۳ نشان داده شده است.

نقطهی کوانتومی عریان ۲۸ اتمی TiO₂ و TiO این نقطهی کوانتومی ۸۸ اتمی دارای ۱۰ واحد تیتانیم و ۱۸ واحد اکسیژن هست. اندازه مؤثر این نقطهی کوانتومی با استفاده از معادلهی اخیر ۸ ۸٬۲۷۵ بهدست آمده است. شکاف انرژی و انرژی کل این نقطهی کوانتومی به ترتیب برابر با eV ۳٬۲۲ و انرژی کل این نقطهی کوانتومی به ترتیب دالتهای این نقطهی کوانتومی در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۳ چگالی حالت نقطه ی کوانتومی عریان ۲۲ اتمی TiO



شکل ۴ چگالی حالت نقطه ی کوانتومی عریان ۲۸ اتمی TiO

2. Highest occupied molecular orbital

سال هفتم، شماره ۳، پاییز ۹۲

^{1.} Lowest unoccupied molecular orbital

مقایسه چگالی حالت توده و نقطهی کوانتومی نشان میدهد که سامانههای نانو نسبت سطح به حجم بسیار زیادی را مهیا میکنند که آنها را قادر میسازد فصل مشترک بسیار بزرگی در حجم بسیار کم ایجاد کنند. سطح بسیار زیادی نیز نانوساختارهای کوانتومی مهیا میکنند. این مزیت یعنی افزایش نسبت سطح به حجم باعث افزایش سطح جاذب نور میشود و به نوبه خود موجب افزایش کارایی میشود. همچنین گاف انرژی نسبت به حالت توده افزایش یافته است این افزایش گاف انرژی در اثر کوچک شدن اندازه ذره از این امر ناشی میشود که اندازهی ذرهی نیم رسانا میشود. بنابراین، بازهی اندازه ذرات برای ظهور اثرات کوانتومی به جرم مؤثری برای ذرهی نیم رسانا کوانتومی نیاز دارد. با کاهش اندازه نقاط کوانتومی، گاف انرژی به این صورت شکل میگیرد:

 $E_g(dot) = E_g(bulk) + Y \gamma_V \cdot /d^{1/4 \gamma}$

گاف انرژی نقطهی کوانتومی، (E_g(bulk) گاف انرژی توده و B قطر نقطهی کوانتومی است. تفاوت شکاف انرژی بین نقاط کوانتومی و توده برابر $\Delta E_g = \beta/d^{\alpha}$ است که β و α در اینجا به ترتیب برابر با ۷۳٬۷۰ و ۱٫۹۳ هست در حالی که برای نقاط کوانتومی III-V و III-V مقدار α بین ۱ و ۱٫۳ و برای نقطههای کوانتومی si برابر ۱٫۶ است. [۹]

الکترون و حفرهی ایجاد شده در ذرات کوانتومی در چاه پتانسیلی با ابعاد هندسی کوچک محبوس شدهاند و تحرک موجود در نیم رساناهای تودهای را، که باعث به وجود آمدن نوار رسانایی و ظرفیت میشوند، ندارند. در نتیجه یک سری حالتهای الکترونی مجزا را به وجود می آورند و گاف انرژی مؤثر نیم رساناها را افزایش میدهد [۱۰ و ۱۱].

پس افزون بر جذب نور، در جدایش الکترون- حفره نیز تأثیر بسزایی دارند. چنین اثراتی، رنگ مواد را به علت تغییر بیشینه جذب نوری و ویژگیهای فوتوکاتالیزوری تغییر میدهد.

همچنین مشاهده می شود که با بزرگتر شدن اندازه نقاط کوانتومی شکاف انرژی کوچکتر می شود. استفاده از نانوساختارها به ما این امکان را می دهد تا ویژگی های نوری آن ها را با کمک اندازه کنترل کرد. زمانی که الکترون حفره در یک نانوذره محدود

می شود. آن ها مقدارهای انرژی دقیقی را می توانند اشغال کنند و فاصلههای بین انرژی ها تابعی از اندازه ذره خواهد بود. محدودیت کوانتمی در وهله اول کنترل جذب نوری را از طریق اندازه ذره مقدور می سازد. بنابراین، نانوذرات توانایی تنظیم ویژگی های نوری سلول خورشیدی را مقدور می سازند. اما در کل نسبت به توده روتیل اندازه گاف انرژی در اثر کوانتومی شدن بیشتر شده است.

نقاط کوانتومی ترمینال شده

در این قسمت اثر ترمینال نقاط کوانتومی با اتم هیدروژن روی گاف انرژی و پایداری نقطهی کوانتومی ۲۸ اتمی بررسی میشود. گاف انرژی و انرژی کل این نقطهی کوانتومی به ترتیب برابر با ۷ eV و ۲۸ ۹۵۲۰/۹۵۸ است. شکل و چگالی حالتهای این نقطهی کوانتومی در شکل ۵ نشان داده شده است: مشاهده میشود که ترمینال پیوندهای آویزان موجب افزایش گاف انرژی و پایداری ساختار میشود که با نتیجههای ارائه شده در مقالات همخوانی دارد [۸ و ۱۲].

از این مقایسهها میتوان نتیجه گرفت که ترمینال کردن و بیاثرسازی، حالتهای سطحی از گاف انرژی راحذف و موجب افزایش گاف انرژی میشود.

نتيجه گيري

فعالیت فوتو ولتائیکی در نیم رساناها به طور عمده وابسته به ۳ فاکتور جذب نور، سرعت اکسایش – کاهش در سطح به وسیله الکترونها و حفرهها و سرعت بازترکیب الکترون و حفره است که در سلولهای خورشیدی بر پایه تیتانیم دی اکسید با استفاده از نقطهی کوانتومی فاز روتیل به جای توده فاز آناتاز، پایداری فاز افزایش یافته و به دنبال آن با کوچک شدن اندازه در حدود کوانتومی نسبت سطح به حجم افزایش یافته و موجب افزایش بازده سلولهای خورشیدی می شود زیرا که بسیاری از واکنشها افزایش گاف انرژی و تشکیل سطوح انرژی گسسته مقیاس زمانی فرایند بازترکیب کاهش می یابد.

مطالعه نظری ساختار و ویژگیهای الکترونیکی روتیل ...



شکل ۵ چگالی حالت نقطه ی کوانتومی ترمینال شده ۲۸ اتمی

- Hagfeldt, A.; Boschloo, G.; Sun, L.; Kloo, L.; Pettersson, H.; Chem. Rev., 110, 6595–6663, 2010.
- [2] Schaller, R.; et al; Nano Lett., 6(3), 424-429, 2006,.
- [3] Xin, X.; "Dye- and quantum dot-sensitized solar cells based on nanostructured widebandgap semiconductors via an integrated experimental and modeling study", Doctor Dissertation, Dep of Materials Science and Engineering, Iowa State University, 2012.
- [4] Nozik, A.J.; Inorganic Chemistry, 44(20), 6893, 2005.
- [5] Peng, H.; Li, J.; J. Phys. Chem. C., 112,

20241-20245, 2008.

- [6] http://www.quantum-espresso.org
- [7] http://rruff.geo.edu.arizona.edu/AMS/result. php?result=rutile

مراجع

- [8] Peng, H.; Li, J.; Li, S.; Bai-Xia, J.; J. Phys. Chem. C., 112, 13964–13969, 2008.
- [9] Li, J.; Wang, L.W.; Phys. ReV. B., 72, 125325, 2005.
- [10]Dilli, Z.; ENEE 313, Spr. 09, 2009.
- [11]Kittel, C.; Introduction to Solid State Physics 8Th Ed, Wiley, 2005.
- [12] Sahoo a, S.K.; Pal a, S.; Sarkar, P.; Majumder, C.; Chemical Physics Letters, 516, 68–71, 2011.



Theoretical study of structure and electronic properties of rutile titanium dioxide to improve the efficiency of solar cells

P. Salehi-Abar^{1,*}, M. Hashemianzade² and V. Mousavi¹

1. MSc in Physical Chemistry, Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2. Associate Prof. of Physical Chemistry, Laboratory Simulation and Research, Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Recieved: August 2013, Revised: October 2013, Accepted: November 2013

Abstract: Due to the nature of photovoltaic in solar cells, the light-absorbing materials will only absorb certain energy level from photon. Therefore, tunable band-gap semiconductors are interesting for the fabrication of sensitized solar cells. In this article the structural and electronic properties of rutile TiO2 quantum dots (QDs) as a function of the size for improving the efficiency of solar cells, are investigated via the first-principle method. Structural properties as total energies, and electronic properties such as density of states and HOMO-LUMO densities have been analyzed.

Keywords: Solar cells, Quantum dots, Recombination, Energy gap, Density of states

^{*}Corresponding author Email: salehia_p@yahoo.com